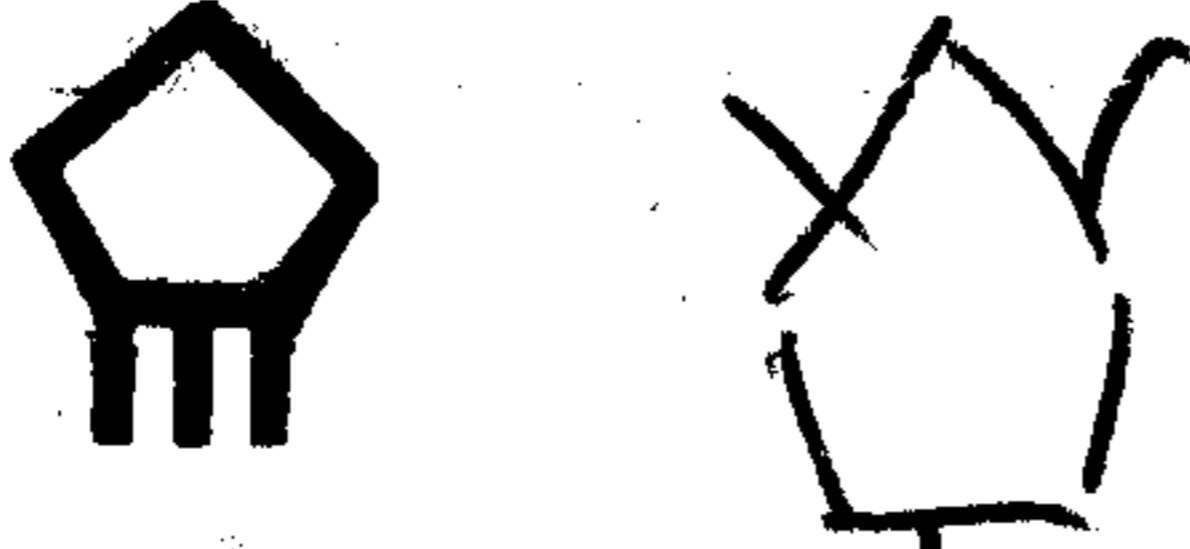


# П А С П О Р Т

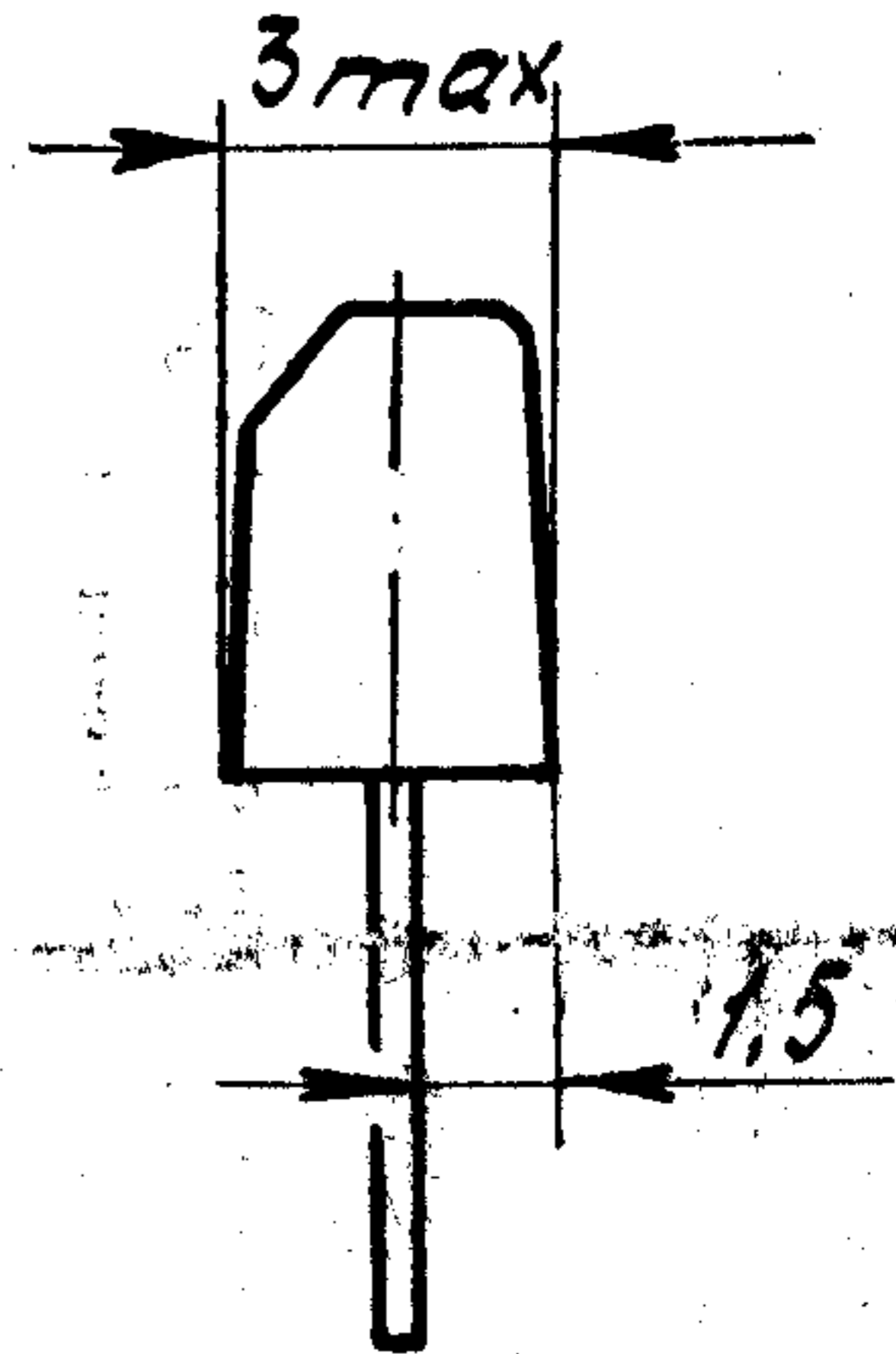
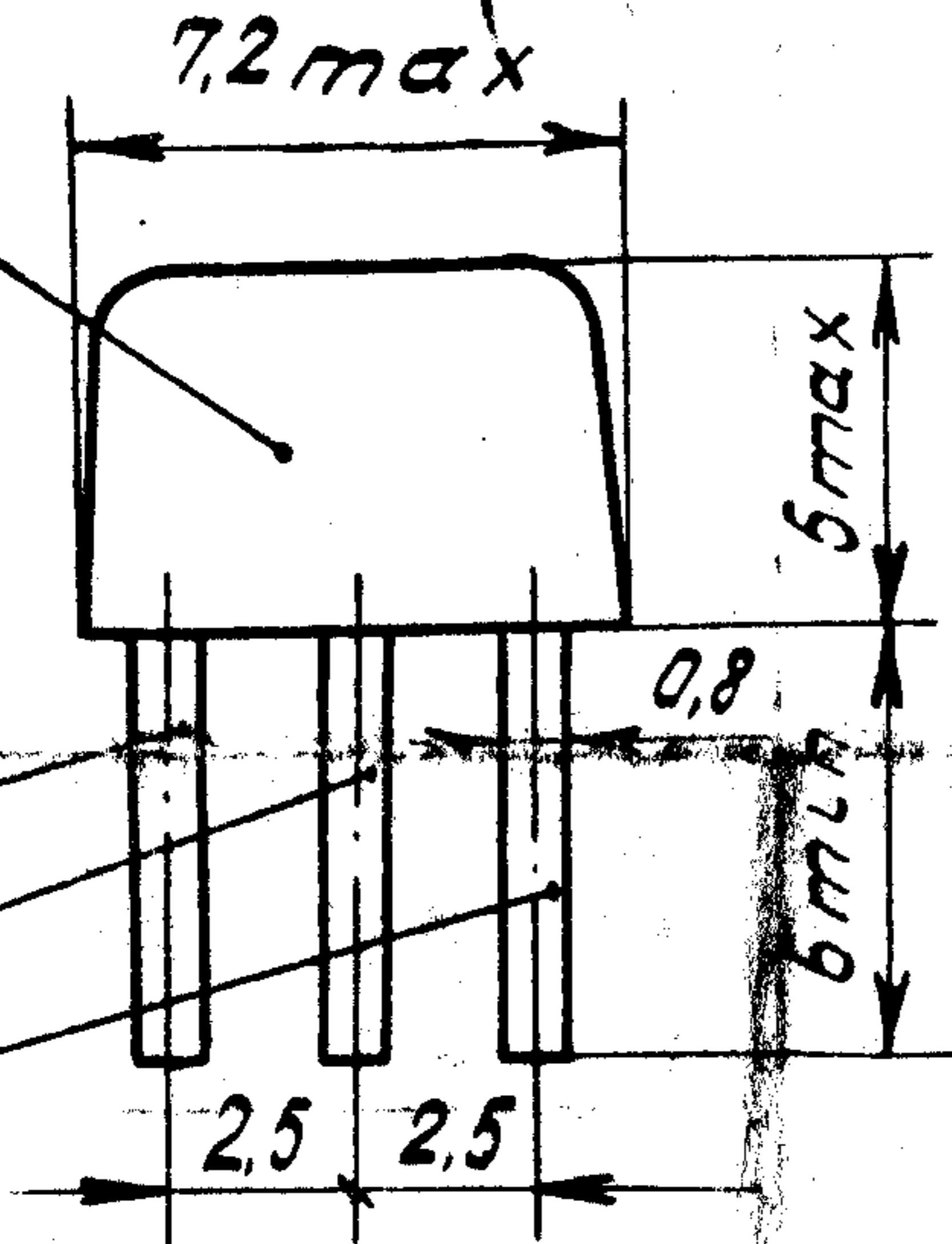
Транзисторы типа ~~КТ361А~~, КТ361Б, ~~КТ361В~~,  
~~КТ361Г~~, ~~КТ361Д~~, ~~КТ361Е~~



Соответствует  
техническим условиям  
ТУ110.336 201 ТУ

Товарный знак
Буква (тип тран- зистора)

Эмиттер
Коллектор
База



Масса 0,3 г.

Содержание золота  
в одном транзисторе  
0,00143 г.

Дата изготовления

2 1978 ?

(месяц, год)

1. Электрические параметры при  $t_{атв} = +25 \pm 10^\circ\text{C}$

Тип транзистора	Начальный ток коллектора $I_{СЕР}$ , ма при $R_{ев} = 10 \text{ ком}$				Статический коэффициент передачи тока в режиме большого сигнала $h_{21E}$ при $U_{СЕ} = 10 \text{ в}$ $I_E = 1 \text{ ма}$		Постоянная времени цепи обратной связи, на высокой частоте $t_{в} \cdot \nu \cdot C_c$ , псек при $U_{СВ} = 10 \text{ в}$ $I_E = 5 \text{ ма}$	Емкость коллекторного перехода $C_c$ , пф при $U_{СВ} = 10 \text{ в}$	Напряжение между коллектором и эмиттером в режиме насыщения $U_{СЕСат}$ , в при $I_C = 20 \text{ ма}$ $I_B = 2 \text{ ма}$	Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте $ h_{21E} $ при $U_{СЕ} = 10 \text{ в}$ $I_E = 5 \text{ ма}$	Обратный ток коллектора $I_{СВО}$ , мма при $U_{СВ} = 10 \text{ в}$
	при $U_{СЕ}$ , в										
	25	20	40	35	не более	не менее	не более	не более	не более	не менее	не более
КТ361А	1				20	90	500	9	0,4	2,5	1
КТ361Б		1			50	350	500	9	0,4	2,5	1
КТ361В			1		20	90	1000	7	0,4	2,5	1
КТ361Г				1	50	350	500	7	0,4	2,5	1
КТ361Д			1		20	90	250	7	1,0	2,5	1
КТ361Е				1	50	350	1000	7	1,0	2,5	1

## 2. Предельно допустимые электрические режимы эксплуатации

Наименование параметра режима	Буквенное обозначение	Норма параметра					
		КТ361А	КТ361Б	КТ361В	КТ361Г	КТ361Д	КТ361Е
Максимально допустимое напряжение между коллектором и эмиттером при $t_{атв} = -60... +35^{\circ}\text{C}$ , в $t_{атв} = +100^{\circ}\text{C}$ , в	$U_{CE\text{ max}}$	25	20	40	35	40	35
	$U_{CE\text{ max}}$	20	15	35	30	35	30
Максимально допустимое напряжение между эмиттером и базой при $t_{атв} = -60... +100^{\circ}\text{C}$ , в	$U_{BE\text{ max}}$	4	4	4	4	4	4
Максимально допустимое напряжение между коллектором и базой при $t_{атв} = -60... +35^{\circ}\text{C}$ , в $t_{атв} = +100^{\circ}\text{C}$ , в	$U_{CB\text{ max}}$	25	20	40	35	40	35
	$U_{CB\text{ max}}$	20	15	35	30	35	30
Максимально допустимая мощность, рассеиваемая коллектором при $t_{атв} = -60... +35^{\circ}\text{C}$ , мВт $t_{атв} = +100^{\circ}\text{C}$ , мВт	$P_c\text{ max}$	150	150	150	150	150	150
	$P_c\text{ max}$	30	30	30	30	30	30
Максимально допустимая температура перехода, $^{\circ}\text{C}$	$t_j\text{ max}$	120	120	120	120	120	120

**Примечание.** При увеличении температуры окружающей среды свыше  $+35^{\circ}\text{C}$  мощность, рассеиваемая коллектором, рассчитывается по формуле

$$P_{c\text{ max}} = \frac{120 - t_{атв}}{R_{thja}}; \quad \text{где } R_{thja} = 0,67^{\circ}\text{C}/\text{мВт}$$

### 3. Условия хранения транзисторов

Условия хранения транзисторов по ГОСТу 11630—70.

### 4. Гарантии

Предприятие-изготовитель гарантирует:

- время гарантийной наработки 5000 часов;
- время хранения 6 лет.

Гарантийный срок исчисляется с момента отгрузки.

### 5. Указания и рекомендации по эксплуатации

Допускается производить соединение выводов транзисторов с элементами схемы любым способом (пайка и др.), кроме ультразвуковой сварки, при соблюдении следующих требований:

а) за время соединения температура в любой точке корпуса транзистора, включая точки контакта выводов с корпусом, не должна превышать максимально допустимой температуры окружающей среды;

б) в процессе соединения должна быть исключена возможность протекания тока через транзистор.

Температура припоя при пайке не должна превышать плюс 260°C, а время пайки — 3 секунды.

Для предохранения транзистора от повреждения пайку производить на расстоянии 2 мм от корпуса, используя в качестве теплоотвода между корпусом транзистора и местом пайки плоский медный пинцет с шириной губок не менее 3 мм и толщиной не менее 3 мм.

В процессе монтажа транзисторы допускают трехкратные изгибы выводов на расстоянии не менее 2-х мм от корпуса транзистора при радиусе изгиба 1,5—2 мм.

Категорически воспрещается кручение выводов вокруг оси.

При включении транзистора в электрическую схему, находящуюся под напряжением, базовый вывод должен подключаться первым и отключаться последним.

Не рекомендуется работать при токах, соизмеримых с неуправляемыми обратными токами, во всем интервале рабочих температур.

Штамп  
ОТК



## 6. Рекламации

В случае преждевременного выхода транзистора из строя данный транзистор вернуть предприятию-изготовителю с указанием следующих данных:

Время хранения \_\_\_\_\_  
(заполняется, если транзистор не был в эксплуатации)

Общее число часов работы транзистора \_\_\_\_\_

Основные данные режима эксплуатации \_\_\_\_\_

(причины снятия транзистора с эксплуатации или хранения, количество

транзисторов данного типа, работавших в аналогичных условиях, но не

отказавших, и общее число часов работы их)

Сведения заполнил \_\_\_\_\_

## ВНИМАНИЕ!

По окончании эксплуатации транзистора (если транзистор снят с эксплуатации после истечения срока гарантийной наработки) просим сообщить предприятию-изготовителю сведения, указанные в разделе 6 паспорта.